



日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 4月28日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-131879

出 願 人

Applicant (s):

株式会社荏原製作所
株式会社東芝

2001年 2月16日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Patent Office

及 川 耕 造

出証番号 出証特2001-3007408

【書類名】	特許願
【整理番号】	P2000-267A
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H01L 21/02
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所 内
【氏名】	牧野 夏木
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所 内
【氏名】	三島 浩二
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所 内
【氏名】	国沢 淳次
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所 内
【氏名】	井上 裕章
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所 内
【氏名】	木村 憲雄
【発明者】	
【住所又は居所】	東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所 内
【氏名】	小田垣 美津子

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所
内

【氏名】 辻村 学

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝
横浜事業所内

【氏名】 松田 哲朗

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝
横浜事業所内

【氏名】 金子 尚史

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝
横浜事業所内

【氏名】 森田 敏行

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 番地 株式会社東芝
横浜事業所内

【氏名】 奥村 勝弥

【特許出願人】

【識別番号】 000000239

【氏名又は名称】 株式会社 荏原製作所

【特許出願人】

【識別番号】 000003078

【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

【識別番号】 100087066

【弁理士】

【氏名又は名称】 熊谷 隆

【電話番号】 03-3464-2071

【選任した代理人】

【識別番号】 100094226

【弁理士】

【氏名又は名称】 高木 裕

【電話番号】 03-3464-2071

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-121841

【出願日】 平成12年 4月21日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 041634

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9005856

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電解処理装置及びその電場状態制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 陽極と陰極の一方の電極との接点を持つ被処理基板と、該被処理基板に対峙させた他方の電極との間に満たした電解液の少なくとも一部に、該電解液の電気伝導率より小さい電気伝導率の高抵抗構造体を設け、

該高抵抗構造体の外形状、内部構造、又は電気伝導率の異なる部材の装着の内の少なくとも一つの調整により、被処理基板表面の電場を制御することを特徴とする電解処理装置の電場状態制御方法。

【請求項 2】 前記外形状の調整は、高抵抗構造体の厚みの調整、高抵抗構造体の平面上での形状の調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする請求項 1 記載の電解処理装置の電場状態制御方法。

【請求項 3】 前記高抵抗構造体は、多孔質物質で構成されており、多孔質物質の内部構造の調整は、多孔質物質の気孔径分布の調整、気孔率分布の調整、屈曲率分布の調整、材料組み合わせの調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする請求項 1 記載の電解処理装置の電場状態制御方法。

【請求項 4】 前記電気伝導率の異なる部材の装着による調整は、電気伝導率の異なる部材によって高抵抗構造体の遮蔽面積を調整することであることを特徴とする請求項 1 記載の電解処理装置の電場状態制御方法。

【請求項 5】 被処理基板及び／又は被処理基板に対峙する電極を回転することを特徴とする請求項 1 ～ 4 の内の何れか 1 項記載の電解処理装置の電場状態制御方法。

【請求項 6】 陽極と陰極の一方の電極との接点を持つ被処理基板と、該被処理基板に対峙させた他方の電極との間に電解液を満たして被処理基板の電解処理を行う電解処理装置において、

前記電解液の少なくとも一部に、該電解液の電気伝導率より小さい電気伝導率の高抵抗構造体を設け、

且つ前記高抵抗構造体の外形状、内部構造、又は電気伝導率の異なる部材の装着の内の少なくとも何れか一つの調整手段によって、被処理基板表面の電場を制

御することを特徴とする電解処理装置。

【請求項 7】 前記外形状の調整手段は、高抵抗構造体の厚みの調整、高抵抗構造体の平面上での形状の調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする請求項 6 記載の電解処理装置。

【請求項 8】 前記高抵抗構造体は、多孔質物質で構成されており、多孔質物質の内部構造の調整手段は、多孔質物質の気孔径分布の調整、気孔率分布の調整、屈曲率分布の調整、材料組み合わせの調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする請求項 6 記載の電解処理装置。

【請求項 9】 前記電気伝導率の異なる部材の装着による調整手段は、電気伝導率の異なる部材によって高抵抗構造体の遮蔽面積を調整することであることを特徴とする請求項 6 記載の電解処理装置。

【請求項 10】 陽極と陰極の一方の電極との接点を持つ被処理基板と、該被処理基板に対峙させた他方の電極との間に電解液を満たして被処理基板の電解処理を行う電解処理装置において、

前記電解液の少なくとも一部に、該電解液の電気伝導率より小さい電気伝導率の高抵抗構造体を設け、

前記高抵抗構造体はその外周が保持部材によって保持されており、且つ高抵抗構造体と保持部材の間にはこの部分から電解液が漏れて電流が流れるのを防止するシール部材が設けられていることを特徴とする電解処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、被処理部材の表面にめっきやエッチング等を施す電解処理装置に関し、特に電解処理装置及びその電場状態制御方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

電解処理、特に電解めっきは、金属膜の形成方法として広く利用されている。近年例えば銅の多層配線用の電解銅めっきや、バンプ形成用の電解金メッキなど、半導体産業などでもその有効性（安価、孔埋め特性など）が注目され利用され

つつある。

【 0 0 0 3 】

一方、L S I 用の半導体基板や液晶基板は、年々大面積となる傾向にありそれに伴う弊害も生じてきた。即ち被処理基板表面に電解めっきを施すには、図 1 9 に示すように、被処理基板（以下単に「基板」という）W の表面に導電層を形成し、基板 W の外周近傍の導電層上に陰極電位を与えるための接点 8 1 を接触し、一方基板 W に対向する位置に陽極 8 3 を設置して陽極 8 3 と基板 W 間にめっき液 8 5 を満たし、前記陽極 8 3 と接点 8 1 間に直流電源 8 7 によって電流を流すことで基板 W の導電層上にめっきを行う。

【 0 0 0 4 】

しかしながら大面積の基板 W の場合、基板 W の外周近傍の接点 8 1 から基板 W 中央までの導電層の電気抵抗が大きくなり、基板 W 面内で電位差が生じ、ひいては各部のめっき速度に差が生じてしまう。即ち図 1 9 には代表的な電解めっきの等価回路が示されているが、回路中には様々な抵抗成分が存在する。

- R 1 電源 8 7 - 陽極 8 3 間の電源線抵抗及び各種接触抵抗
- R 2 陽極 8 3 における分極抵抗
- R 3 めっき液 8 5 抵抗
- R 4 陰極（基板 W のめっき表面）における分極抵抗
- R 5 導電層の抵抗
- R 6 接点 8 1 - 電源 8 7 間の電源線抵抗及び各種接触抵抗

【 0 0 0 5 】

図 1 9 から明らかなように、抵抗 R 5 が他の電気抵抗 R 1 ~ R 4 及び R 6 に比して大きくなると、抵抗 R 5 の両端に生じる電位差が大きくなり、それに伴うめっき電流の差が生じ、接点 8 1 から遠い位置ではめっき膜成長速度が低下してしまい、導電層の膜厚が薄いと抵抗 R 5 が更に大きくなってこの現象が顕著に表れてしまう。さらにこの事実は、基板 W の面内で電流密度が異なることを意味し、めっきの特性自体（めっき膜の抵抗率、純度、埋込特性など）が面内で均一とならない。

【 0 0 0 6 】

なお基板Wが陽極になる電解エッチングにおいても電流方向が反対となるだけで同様の問題が生じる。例えば大口径のウエハプロセスではウエハ中央部のエッチング速度が周縁部に比して遅くなる。

【 0 0 0 7 】

以上の問題回避の方法としては導電層の厚さを厚くしたり電気導電率を小さくすることが考えられる。しかしながら基板Wはめっき以外の製造工程でも様々な制約を受けるばかりでなく、例えば微細パターン上にスパッタ法で厚い導電層を形成するとパターン内部にボイドが発生し易くなってしまうため、容易に導電層の厚みを厚くしたり導電層の膜種を変更することはできない。

【 0 0 0 8 】

そしてこの欠点を防止するため、本願発明者は図20に示すように、陽極38と被処理基板Wの間にめっき液10の電気伝導率よりも小さい電気伝導率の高抵抗構造体4を設置する発明をした。即ちこのように構成すると同図に示すような等価回路となるが、前記図19に示す等価回路に比べて高抵抗構造体4によって抵抗 R_p が追加される。そして抵抗 R_p が大きな値となった場合、 $(R_2 + R_3 + R_p + R_4) / (R_2 + R_3 + R_p + R_4 + R_5)$ は1に近づき、抵抗 R_5 、即ち導電層の抵抗成分の影響を受けにくくなる。

【 0 0 0 9 】

しかしながら上記高抵抗構造体4としてその全体が均一組成で単純形状（例えば円板等）のものをを用いただけでは、必ずしも十分なめっき膜厚の面内分布の制御が望めない場合もあった。即ち上記高抵抗構造体4を用いてもめっき膜厚を完全に均一化しにくい部分（例えば基板Wの外周近傍部分）も均一化するように制御したいような場合や、逆にめっき膜厚を基板W表面の各部それぞれで異なるように制御したいような場合があり、このような場合は単に高抵抗構造体4を介在させるだけでは十分ではなかった。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上述の点に鑑みてなされたものでありその目的は、積極的に電場状態を制御することで、目的とする膜厚の面内分布となるように制御することができ

る電解処理装置及びその電場状態制御方法を提供することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記問題点を解決するため本発明にかかる電解処理装置における電場状態制御方法は、陽極と陰極の一方の電極との接点を持つ被処理基板と、該被処理基板に対峙させた他方の電極との間に満たした電解液の少なくとも一部に、該電解液の電気伝導率より小さい電気伝導率の高抵抗構造体を設け、該高抵抗構造体の外形状、内部構造、又は電気伝導率の異なる部材の装着の内の少なくとも一つの調整により、被処理基板表面の電場を制御することを特徴とする。このように被処理基板表面の電場の状態が所望の状態になるように積極的に制御すれば、被処理基板の電解処理による処理状態を目的とする面内分布の処理状態とすることができる。電解処理がめっき処理の場合は、被処理基板上に形成されるめっき膜厚の均一化を図ったり、被処理基板上のめっき膜厚に任意に分布を持たせたりすることができる。

【0012】

ここで前記外形状の調整は、高抵抗構造体の厚みの調整、高抵抗構造体の平面上での形状の調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする。

【0013】

また前記高抵抗構造体は、多孔質物質で構成されており、多孔質物質の内部構造の調整は、多孔質物質の気孔径分布の調整、気孔率分布の調整、屈曲率分布の調整、材料組み合わせの調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする。

【0014】

また前記電気伝導率の異なる部材の装着による調整は、電気伝導率の異なる部材によって高抵抗構造体の遮蔽面積を調整することであることを特徴とする。

【0015】

また本発明は、前記被処理基板及び／又は被処理基板に対峙する電極を回転することを特徴とする。

【0016】

また本発明は、陽極と陰極の一方の電極との接点を持つ被処理基板と、該被処理基板に対峙させた他方の電極との間に電解液を満たして被処理基板の電解処理を行う電解処理装置において、前記電解液の少なくとも一部に、該電解液の電気伝導率より小さい電気伝導率の高抵抗構造体を設け、且つ前記高抵抗構造体の外形状、内部構造、又は電気伝導率の異なる部材の装着の内の少なくとも何れか一つの調整手段によって、被処理基板表面の電場を制御することを特徴とする。

【 0 0 1 7 】

ここで前記外形状の調整手段は、高抵抗構造体の厚みの調整、高抵抗構造体の平面上での形状の調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

また前記高抵抗構造体は、多孔質物質で構成されており、多孔質物質の内部構造の調整手段は、多孔質物質の気孔径分布の調整、気孔率分布の調整、屈曲率分布の調整、材料組み合わせの調整の内の少なくとも何れか一つであることを特徴とする。

【 0 0 1 9 】

また前記電気伝導率の異なる部材の装着による調整手段は、電気伝導率の異なる部材によって高抵抗構造体の遮蔽面積を調整することであることを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

また本発明は、陽極と陰極の一方の電極との接点を持つ被処理基板と、該被処理基板に対峙させた他方の電極との間に電解液を満たして被処理基板の電解処理を行う電解処理装置において、前記電解液の少なくとも一部に、該電解液の電気伝導率より小さい電気伝導率の高抵抗構造体を設け、前記高抵抗構造体はその外周が保持部材によって保持されており、且つ高抵抗構造体と保持部材の間にはこの部分から電解液が漏れて電流が流れるのを防止するシール部材が設けられていることを特徴とする。

【 0 0 2 1 】

ところで上記高抵抗構造体 4 としては、アルミナ製多孔質セラミックスや、炭化シリコンセラミックスがあげられる。また塩化ビニールを繊維状に束ね、これ

を互いに溶着させたものを用いて形成したもの、またポリビニルアルコールなどの発泡体やテフロン（商標名）などの繊維を織布や不織布の形態に整形したものを用いて高抵抗構造体を構成してもよい。更に、これらや導体と絶縁体、或いは導体同士を組み合わせた複合体でもよい。また 2 枚の隔膜の間に、他の種類の電解液をはさんだ構造物で高抵抗構造体を構成することも可能である。

【 0 0 2 2 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。

〔電場状態制御手段として絶縁性部材を用いた実施形態〕

図 1 は本発明の一実施形態を適用した電解めっき装置の概略構成図である。同図に示す電解めっき装置は、いわゆるフェイスアップ方式を採用した電解めっき装置であり、被処理基板（以下単に「基板」という）W は上向きに基板載置台 3 0 上に載置されている。基板 W の周辺はリング状に形成されたリップシール 3 4 の先端が当接してシールされ、その内側にめっき液 1 0 が充填されている。また基板 W 表面のリップシール 3 4 の外方には、基板 W 表面の導電層に接触して基板 W に陰極電位を印加する接点 3 6 が設置されている。

【 0 0 2 3 】

基板 W の上方には所定の隙間を介して円板状の高抵抗構造体 4 と円板状の陽極 3 8 とが保持部材 3 2 に保持されて設置されている。ここで陽極 3 8 には厚み方向に貫通する多数の細孔 3 9 が設けられ、陽極 3 8 の上には前記各細孔 3 9 にめっき液を分配して供給するめっき液導入管 4 1 が設置されている。

【 0 0 2 4 】

一方高抵抗構造体 4 はこの実施形態では多孔質セラミックス板（例えば気孔率 2 0 %、平均ポア径 5 0 μ m で厚さが 1 0 m m の S i C 製）4 0 の内部にめっき液 1 0 を含有させることで構成されている。また陽極 3 8 は保持部材 3 2 と多孔質セラミックス板 4 0 によって完全に被覆された構造となっている。

【 0 0 2 5 】

そして本実施形態においては、多孔質セラミックス板（多孔質物質）4 0 の外周側面にこれを囲むようにバンド状の絶縁性部材 5 0 を巻きつけている。この絶

縁性部材 5 0 の材質としては、例えばフッ素ゴムのような伸縮性材料を用いる。

【 0 0 2 6 】

そしてめっき液導入管 4 1 から陽極 3 8 の細孔 3 9 を通して多孔質セラミックス板 4 0 に加圧供給されためっき液は、多孔質の多孔質セラミックス板 4 0 内に浸透してその内部をめっき液で満たすと共に、その下面から吐出して基板 W と多孔質セラミックス板 4 0 の間の空間をめっき液 1 0 で満たす。なおめっき液 1 0 の導入はリップシール 3 4 と多孔質セラミックス板 4 0 の端面との隙間から行ってもよい。この場合はめっき液導入管 4 1 や陽極 3 8 の細孔 3 9 は不要である。

【 0 0 2 7 】

そして陽極 3 8 と基板 W 間に所定の電圧を印加して直流電流を流すと、基板 W の導電層の表面全体にめっき（例えば銅めっき）が行われていく。本実施形態によれば、陽極 3 8 と基板 W の間に多孔質セラミックス板 4 0 を介在しているので、前述のように基板 W 表面の接点 3 6 からの距離の相違による各部の抵抗値の違いによる影響を受けにくく、基板 W の導電層の表面全体に略均一なめっき（例えば銅めっき）が行われていく。

【 0 0 2 8 】

しかしながら接点 3 6 に近い外周部近傍部分はそれでも電流密度が高くなり、めっき膜厚は他の部分に比べて厚くなる傾向にある。

【 0 0 2 9 】

そこで本実施形態においては、多孔質セラミックス板 4 0 の外周側面に絶縁性部材 5 0 を巻き付けることで、図 1 に点線で示すように、基板 W の外周部近傍に電流が集中するのを阻害してその電流密度を低下させ、基板 W の他の部分に向かう電流密度と略同じになるようにしたのである。

【 0 0 3 0 】

図 2 は上記方法を用いて基板 W に銅めっきを行った際の基板 W の外周部分近傍の銅めっきの膜厚を測定した結果を示す図である。同図に示すように、絶縁性部材 5 0 の幅 L（図 1 参照）を変更することで、基板 W の外周部近傍の銅めっきの膜厚が変化することがわかる。即ち幅 L が長くなればなるほど、基板 W の外周部近傍の電流密度が低くなってめっき膜厚が薄くなる。そこで絶縁性部材 5 0 の幅

Lを所望のもの（例えば $L = 4 \text{ mm}$ ）にすることで、基板Wの外周部近傍のめっき膜厚を他の部分と同一にすることができる。このように絶縁性部材50は幅Lの長さにより多孔質セラミックス板40の外周側面の遮蔽面積を調整するものであるが、絶縁性部材50の遮蔽面積の調整は幅Lのみならず、遮蔽物自体に孔をあけて遮蔽面積を調整してもよい。

【0031】

なお本発明は必ずしも基板Wの外周部近傍のめっき膜厚を他の部分と同一のめっき膜厚にする場合だけに利用するものではなく、例えば基板Wの外周部近傍のめっき膜厚を他の部分よりも厚くしたいような場合は絶縁性部材50の幅Lを小さくすれば良いし、逆の場合は大きくすれば良い。即ち本実施形態によれば、基板Wの外周部近傍のめっき膜厚を自由に所望のものに制御することができる。

【0032】

図3は本発明の他の実施形態を示す図である。この実施形態において前記図1に示す実施形態と相違する点は、バンド状の絶縁性部材50を取り付ける代りに、多孔質セラミックス板40の外周に可動式で筒状の絶縁性部材50-2を設置した点である。この絶縁性部材50-2は絶縁性部材保持具51の下端に設けられている。絶縁性部材保持具51は図示しない上下動駆動機構によって上下動自在に構成されている。このように構成すれば、絶縁性部材50-2の位置を上下動させることによって多孔質セラミックス板40に対して可動して多孔質セラミックス板40の外周側面の露出面積を調節することにより、基板Wの外周部近傍の電流密度を任意に制御することができ、図1に示す実施形態と同様に基板Wの外周部近傍のめっき膜厚を任意に調整することができる。

【0033】

図4は本発明の他の実施形態を示す図である。この実施形態において前記図1に示す実施形態と相違する点は、バンド状の絶縁性部材50を取り付ける代りに、多孔質セラミックス板40の外周側面自体に絶縁材料を塗布又は浸透させることで、絶縁性部材50-3を設けた点である。例えば多孔質セラミックス板40の外周側面に、絶縁材料としてガラスや樹脂またはシリコンなどを浸透させる。浸透幅及び浸透深さ分布を調節することにより、基板Wの外周部近傍の電流密度

を任意に制御することができ、図 1 に示す実施形態と同様に基板 W の外周部近傍のめっき膜厚を任意に調整することができる。さらに母材（例えば SiC）の一部を酸化することで電流密度を制御することも可能である。

【0034】

〔シール部材を用いた実施形態〕

図 5 は図 1 に示すと同様の構造の電解めっき装置の多孔質セラミックス板 40 の外周部近傍部分を示す要部概略図である。但しこの電解めっき装置には図 1 に示す絶縁性部材 50 は記載されていない。この電解めっき装置においては保持部材 32 と多孔質セラミックス板 40 の間の隙間がシールされていないので、矢印で示すようにこの隙間部分を通して陽極 38 からめっき液が流れ出し、電流の通路が生じる。この電流通路は多孔質セラミックス板 40 の内部を通らない通路なので抵抗値が低く、従って電流密度が高くなって基板 W の外周部近傍のめっき膜厚を薄くしようとする制御ができなくなる恐れがある。

【0035】

そこでこの実施形態においては、図 6 に示すように前記多孔質セラミックス板 40 と保持部材 32 の間にシール部材 60 を設けることで、この部分からのめっき液の漏れを防止して基板 W の外周部近傍のめっき膜厚を薄く制御できるようにしている。

【0036】

なおこの実施形態におけるシール部材 60 は断面逆 L 字状であり、また絶縁物によって構成されるので、図 1 に示す絶縁性部材としての作用も併せて持っている。またシール部材 60 は、図 6（b）にその断面を示すように、保持部材 32 と多孔質セラミックス板 40 の下面とが接する部分をシールする環状のシール部材部 601 と、図 1 に示すバンド状の絶縁性部材 50 と同様の機能を発揮する絶縁性部材部 603 とを、別部品として各々取り付けることで構成しても良い。

【0037】

なおこのシール部材 60 は、図 1 以外の各実施形態にも適用できることは言うまでもない。即ち高抵抗構造体 4 の外周側面と保持部材 32 の間からのめっき液の漏れを防止するシール部材 60 を他の各種実施形態に係る電場制御手段と併用

することで、さらに効果的な電場制御が行える。

【 0 0 3 8 】

〔電場状態制御手段として陽極と基板との間の電流密度を高くしようとする部分に高抵抗構造体が介在しない部分を設ける実施形態〕

図 7 は本実施形態を適用した電解めっき装置の概略構成図である。同図においては図 1 に示す実施形態と相違して高抵抗構造体 4 の外周に絶縁性部材 5 0 を取り付けないで、その代わりに高抵抗構造体 4 自体の形状自体を変更することでめっき膜厚の制御を行っている。

【 0 0 3 9 】

図 8 (a) ~ (d) は図 7 に示す電解めっき装置に用いる高抵抗構造体 4 の平面図である。即ちこの実施形態における高抵抗構造体 4 は、例えば多孔質セラミックス板 4 0 であり、同図 (a) に示すように多孔質セラミックス板 4 0 の外周形状を多角形にしたり、同図 (b) に示すように所定の間隔毎にスリット 6 5 を設けたり、同図 (c) に示すように波型 (又は歯車型) にしたりしている。これに対して陽極 3 8 と基板 W は一点鎖線で示すように円形なので、基板 W の外周付近には多孔質セラミックス板 4 0 を介在しないでめっき液 1 0 だけを介在して陽極 3 8 と対向する部分が生じることとなり、多孔質セラミックス板 4 0 が介在する部分に比べて陽極 3 8 と基板 W 間の電気抵抗が低下し、基板 W の外周部の電流密度が高くなる。従ってこれらの実施形態の場合は、基板 W の外周付近のめっき膜厚を、中央付近のめっき膜厚に比べて厚くしたいような場合に利用できる。

【 0 0 4 0 】

また基板 W の中央部分など、基板 W の外周部分以外の他の部分のめっき膜厚を厚く制御しようとする場合は、図 8 (d) のように多孔質セラミックス板 4 0 の内部に穴 6 6 を設けることで陽極 3 8 と基板 W との間に多孔質セラミックス板 4 0 が介在しない部分を設けるようにすれば良い。

【 0 0 4 1 】

なお図 7 に示す電解めっき装置において基板 W を回転することで、基板 W 全面に渡って均一な膜厚のめっきが行える。基板 W の回転に代えて、又は基板 W の回転と共に、保持部材 3 2 側を回転させても良い。なお基板 W 及び / 又は保持部材

3 2 を回転させることは、図 7 に限られるものではない。

【 0 0 4 2 】

〔電場状態制御手段として高抵抗構造体の厚みに分布を持たせた実施形態〕

図 9 は本実施形態を適用した電解めっき装置の概略構成図である。同図に示す電解めっき装置においては、高抵抗構造体 4 の厚みに二次元的分布を持たせ、これによって基板 W 表面における電流密度分布が所望のものとなるように制御し、めっき膜厚を制御している。即ちこの実施形態においては高抵抗構造体 4 は例えば多孔質セラミックス板 4 0 であり、多孔質セラミックス板 4 0 を円形であって中心部の厚みが周辺部の厚みよりも薄くなるように構成している。このように構成すれば、中央部における陽極 3 8 と基板 W 間の抵抗値を周辺部の抵抗値よりも低くできるので、前述したように中心に近いほど薄くなる傾向のめっき膜厚を均一になるように制御することができる。

【 0 0 4 3 】

図 1 0 は多孔質セラミックス板 4 0 が均一厚みのものと、図 9 に示すような分布厚みのものを用いて基板 W 上にめっきを行った際のめっき膜厚の測定値を比較して示す図である。同図からわかるように図 9 の多孔質セラミックス板 4 0 を用いた方が、基板 W 上のめっき膜厚の均一化が図れることがわかる。なお図 1 1 に示すように図 9 に示す多孔質セラミックス板 4 0 を逆向き構造にして設置しても、図 9 の場合と同様の効果が得られる。

【 0 0 4 4 】

同様に図 1 2 に示すように多孔質セラミックス板 4 0 の中央の厚みの方を周辺部の厚みよりも厚くすることによって周辺部のめっき膜厚の方を中央部よりも厚くするようにしても良いし、図 1 3 に示すように多孔質セラミックス板 4 0 に貫通孔 6 7 を設けることで貫通孔 6 7 を設けた部分のめっき膜厚を他の部分に比べて厚くするようにしても良い。また図 1 4 に示すように多孔質セラミックス板 4 0 の外周角部を面取り形状とすることでその厚みを薄くして他の部分よりも電気抵抗を低下させて基板 W の外周近傍のめっき膜厚を他の部分よりも厚くするようにしても良い。要は高抵抗構造体 4 の厚み（厚み = 0 も含める）に分布を持たせることで各部のめっき膜厚を所望のものに制御するのであれば良い。

【 0 0 4 5 】

〔電場状態制御手段として多孔質物質の気孔構造に分布を持たせた実施形態〕

図 1 5 は本実施形態を適用した電解めっき装置の概略構成図である。同図に示す電解めっき装置においては、高抵抗構造体 4 として気孔構造が二次元分布又は三次元分布を持つ多孔質物質（例えばポーラスセラミックス）4 0 を用いている。多孔質物質 4 0 は気孔の径や数、配列状態などによってその内部に保持するめっき液の量や保持状態が異なり、これによって抵抗値が相違する。そこでこの実施形態においては、中央付近の気孔構造 C 1 を外周付近の気孔構造 C 2 と異ならせ、中央付近の気孔構造 C 1 の方が低抵抗になるようにしている。このように構成すれば、中央付近の電流密度が増大してその部分のめっきが形成されやすくなる。もちろん逆に外周付近の気孔構造 C 2 の方が低抵抗となるように構成して外周付近のめっき膜厚を厚くするようにすることもできる。また三種類以上の気孔構造を用いて、より複雑なめっき膜厚の制御を行っても良い。

【 0 0 4 6 】

気孔構造に分布を与える方法としては、図 1 5 に示すように多孔質物質 4 0 の一体成形時に分布を与える方法や、図 1 6 (a) , (b) に示すように、多孔質物質 4 0 の内の気孔構造の異なる部分 C 1 , C 2 を別々に成形し、その後組み立てによって一体化する方法などがある。

【 0 0 4 7 】

気孔構造の要素としては、気孔径（例えば 5 0 ~ 4 0 0 μ m の範囲で径を異ならせる）、連続気孔率（気泡同士がつながっている度合い…つながっている方が抵抗値が小さくなる）、屈曲率（つながっている気孔の厚み方向の曲がり具合…曲がりが少ない方が抵抗値は小さくなる）などがある。

【 0 0 4 8 】

気孔構造を異ならせるには、例えばその材質自体を異ならせても良い（例えば樹脂系材料とセラミックス系材料など）。また多孔質物質 4 0 の気孔率の分布を制御する手段として、多孔質物質 4 0 （ここではポーラスセラミックス）の表面若しくは内部の少なくとも一部を封孔処理する（樹脂やシラノール系の塗布型絶縁膜を使用する、母材の S i C を一部酸化するなど）方法もある。また、面一様

に封孔処理を施した後に一部の封孔部を開孔して、面内の気孔分布を変える方法もある。

【 0 0 4 9 】

また多孔質物質 4 0 の材料としては、図 1 7 に示すような異方性構造材料もある。即ち図 1 7 (a) に示す方向性多孔質構造材料や、図 1 7 (b) に示す繊維型多孔質構造材料などである。これら異方性構造材料を構成する材質としては樹脂、セラミックなどがある。これら異方性構造材料は特定方向に気孔がつながっていて特定方向に電流が流れ易くなっており（別の方向には電流が流れにくくなっている）、電流密度の制御性が向上できる。そして多孔質物質 4 0 の中央付近の気孔構造 C 1 と外周付近の気孔構造 C 2 とをこの異方性構造材料を用いて異ならせることで基板 W 表面に印加される電流密度分布を所望のものにすることができる。

【 0 0 5 0 】

以上本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の変形が可能である。なお直接明細書及び図面に記載がない何れの形状や材質であっても、本願発明の作用・効果を奏する以上、本願発明の技術的思想の範囲内である。

【 0 0 5 1 】

例えば上記実施形態では本発明を、いわゆるフェイスアップ方式の電解めっき装置に適用した例を示したが、図 1 8 に示すようないわゆるフェイスダウン方式の電解めっき装置にも適用可能である。即ちこの電解めっき装置は、めっき液 1 0 を保持するカップ状のめっき槽 1 2 を具備し、このめっき槽 1 2 の底部に円板形状の陽極 1 4 を設置し、その上に円板状の高抵抗構造体 2 4 を設置し、めっき槽 1 2 の周囲にこのめっき槽 1 2 の上部からオーバーフローしためっき液 1 0 を回収するめっき液受け 1 6 を配置し、さらにめっき槽 1 2 の上部に設置したリップシール 1 8 の上に基板 W を載せ、基板 W の下面外周に接点 2 0 を接触させて構成されている。

【 0 0 5 2 】

そして陽極 1 4 の中央に設けた貫通孔 1 4 a と高抵抗構造体 2 4 の中央に設けた小孔 2 4 a を介してめっき液を循環させながら、陽極 1 4 と基板 W 間に電圧を印加して電流を流せば、基板 W の下面上にめっき層が形成されていく。

【 0 0 5 3 】

そして前記各実施形態のように、高抵抗構造体 2 4 の外周に絶縁性部材を設けたり、厚みを変えたり、気孔構造を変えたりすることで、基板 W 上に形成されるめっき膜厚の分布を所望の分布にすることができる。

【 0 0 5 4 】

また本発明は、図 2 1 に示すように密閉式の電解めっき装置にも適用可能である。即ちこの電解めっき装置は、箱型のめっき槽 1 5 0 を有し、このめっき槽 1 5 0 の一方の開口端は、陽極板 1 5 2 で閉塞され、他方の開口端は、基板 W をめっき槽 1 5 0 側に保持した蓋体 1 5 4 で開閉自在に閉塞されるようになっている。基板 W と陽極板 1 5 2 の間には、高抵抗構造体 1 7 6 として 2 枚のメッシュ 1 6 2 a, 1 6 2 b によって保持された 2 枚の隔膜 1 6 0 a, 1 6 0 b によって挟まれた高抵抗電解液室 1 6 8 を区画形成したものが設置されている。

【 0 0 0 5 5 】

そしてめっき室 1 6 4 にめっき液 1 7 0 を、電解液室 1 6 6 に電解液（めっき液） 1 7 2 をそれぞれ導入し、循環させながら陽極板 1 5 2 と基板 W 間に電圧を印加して電流を流せば、基板 W にめっき層が形成されていく。

【 0 0 5 6 】

そして前記各実施形態のように、高抵抗構造体 1 7 6 の面上に絶縁性部材を設けたり、メッシュ 1 6 2 a, 1 6 2 b の面を加工して高抵抗電解液室 1 6 8 の厚み等の形状を変えることで、基板 W 上に形成されるめっき膜厚の分布を所望の分布にすることができる。

【 0 0 5 7 】

なお隔膜 1 6 0 a, 1 6 0 b の種類としては、強酸性カチオン交換膜、例えばトクヤマ製 CMS やデュポン社製 N - 3 5 0 などを使用するのが一般的であるが、カチオンの選択性を変える、あるいはアニオン交換膜、ノニオン交換膜としてもよい。高抵抗電解液室 1 6 8 中の電解質としては $(50 \sim 200 \text{ g/l}) \text{H}_2$

SO_4 が一般的であるが、任意の濃度を選択したり、電解質は硫酸として限定されるものではないのは当然である。

【0058】

また本発明は更に他の各種構造の電解めっき装置（フェイスアップ、フェイスダウンの何れの方式をも含む）にも適用できることは言うまでもない。さらに上記各実施形態では本発明を電解めっき装置に適用した例を示したが、その代わりに基板を陽極にして行う電解エッチング装置に適用してもよい。

【0059】

また上記各実施形態においては、被処理基板として円形のものを用い、電界分布も全て同心円状のものを示したが、被処理基板は円形以外の各種形状のものであってもよいし、また電界分布も必要に応じて非同心円状のものであってもよい。例えば被処理基板としてLCDなどの板状（円形以外の形状を含む）のものを用いてもよいし、また陰極接点36はリング状ではなく、一方向から被処理基板に接触するものであってもよい。また陰極接点36は被処理基板の外周以外の位置に接触させてもよい。

【0060】

【発明の効果】

以上詳細に説明したように本発明によれば、被処理部材表面の電場の状態が所望の状態になるように積極的に制御したので、被処理部材の電解処理による処理状態を目的とする面内分布の処理状態とすることができるという優れた効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態を適用した電解めっき装置の概略構成図である。

【図2】

基板Wに銅めっきを行った際の基板Wの外周部分近傍の銅めっきの膜厚測定結果を示す図である。

【図3】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 4】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 5】

電解めっき装置の多孔質セラミックス板 4 0 の外周部近傍部分を示す要部概略図である。

【図 6】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 7】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 8】

図 8 (a) ～ (d) は図 7 の電解めっき装置に用いる高抵抗構造体 4 の平面図である。

【図 9】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 0】

多孔質セラミックス板 4 0 が均一厚みのものと、図 9 に示すような分布厚みのものを用いて基板 W 上にめっきを行った際のめっき膜厚の測定結果を示す図である。

【図 1 1】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 2】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 3】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 4】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 5】

本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 6】

図 1 6 (a) , (b) は本発明の他の実施形態を示す図である。

【図 1 7】

図 1 7 (a) , (b) は異方性構造材料の一例を示す図である。

【図 1 8】

フェイスダウン方式の電解めっき装置を示す図である。

【図 1 9】

従来の電解めっき装置を示す図である。

【図 2 0】

本発明に用いる電解めっき装置の基本構成を示す図である。

【図 2 1】

密閉式の電解めっき装置を示す図である。

【符号の説明】

W 被処理基板

1 0 めっき液 (電解液)

3 0 基板載置台

3 2 保持部材

3 4 リップシール

3 6 接点

3 8 陽極

3 9 細孔

4 高抵抗構造体

4 0 多孔質セラミックス板 (多孔質物質)

4 1 めっき液導入管

5 0 絶縁性部材

5 0 - 2 絶縁性部材

5 1 絶縁性部材保持具

5 0 - 3 絶縁性部材

6 0 シール部材

6 5 スリット

6 7 貫通孔

C 1, C 2 気孔構造

1 2 めっき槽

1 4 陽極

1 4 a 貫通孔

1 6 めっき液受け

1 8 リップシール

2 0 接点

2 4 高抵抗構造体

2 4 a 小孔

1 7 6 高抵抗構造体

1 5 0 めっき槽

1 5 2 陽極板

1 5 4 蓋体

1 6 0 a, 1 6 0 b 隔膜

1 6 2 a, 1 6 2 b メッシュ

1 6 4 めっき室

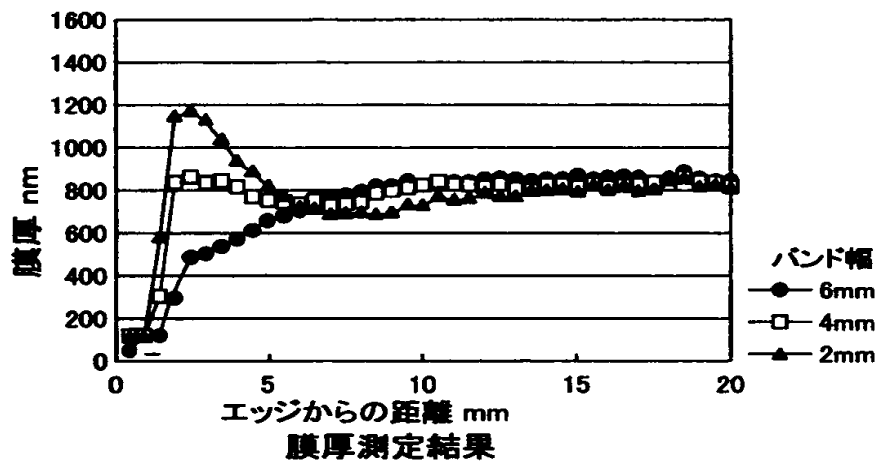
1 6 6 電解液室

1 6 8 高抵抗電解液室

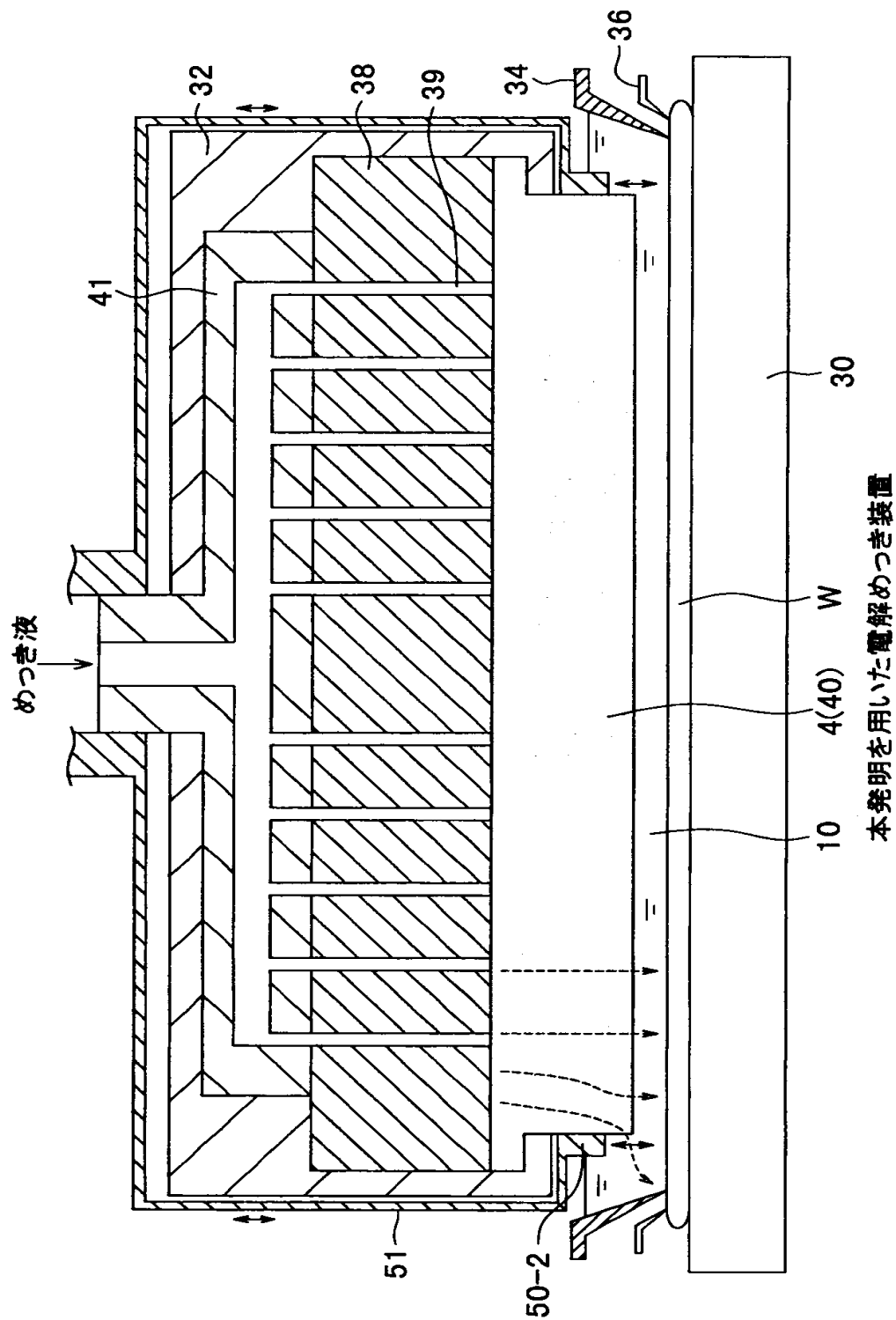
1 7 0 めっき液

1 7 2 電解液 (めっき液)

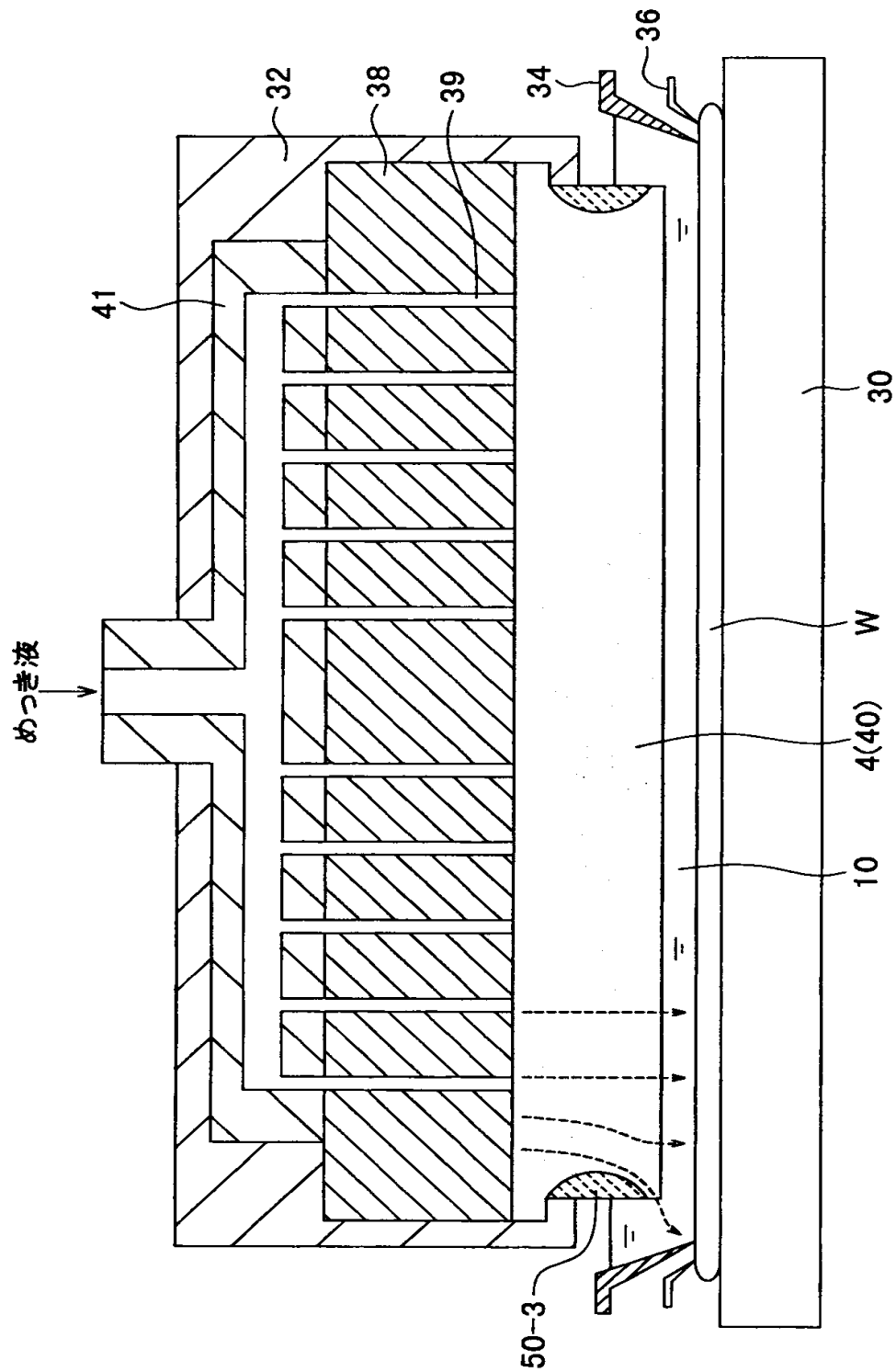
【図 2】



【図3】

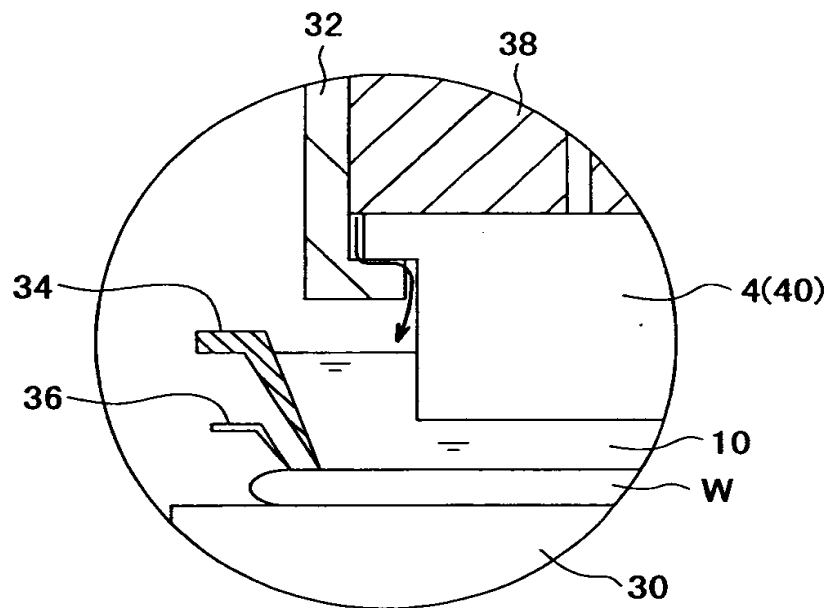


【図 4】



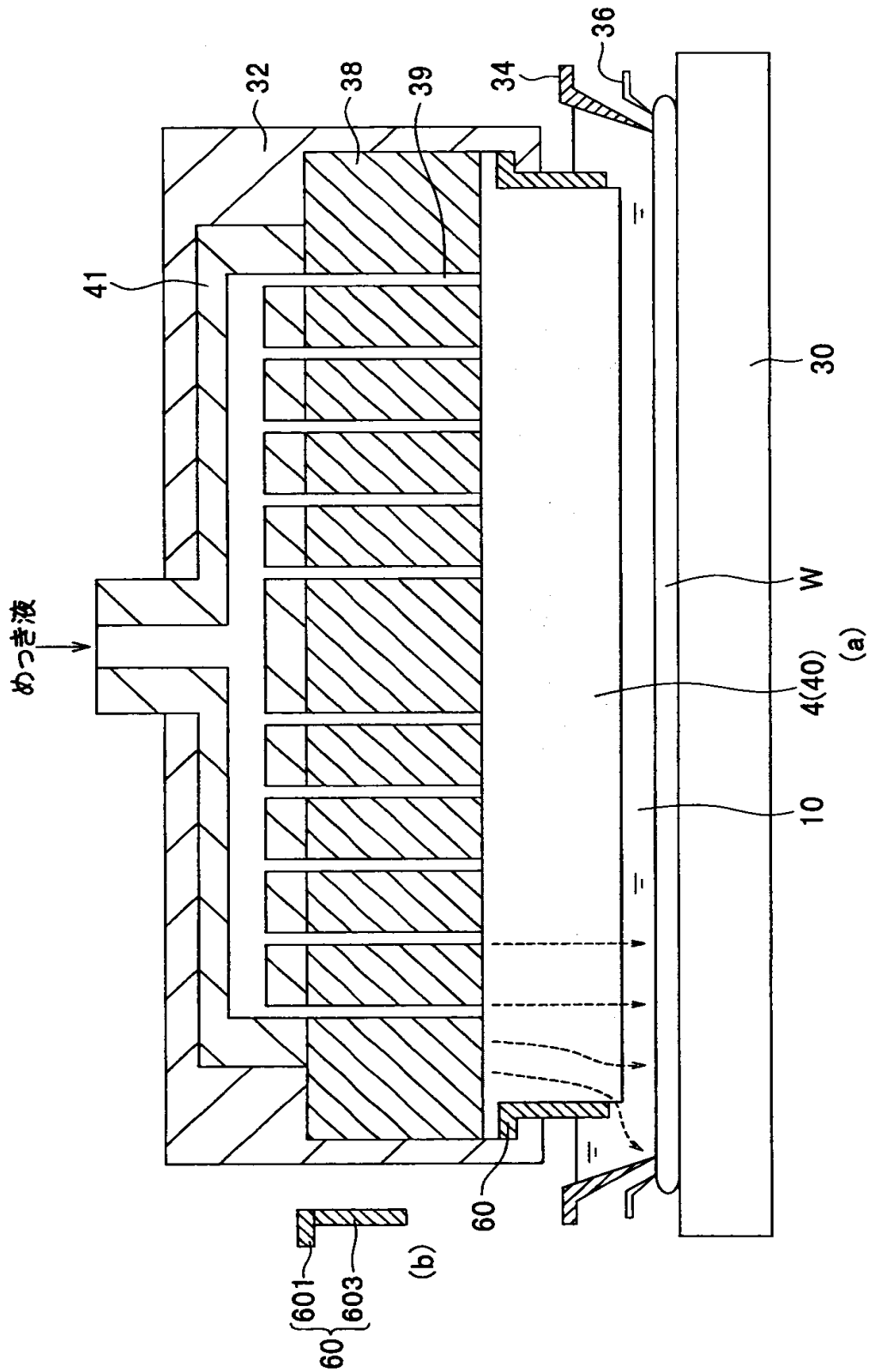
本発明を用いた電解めっき装置

【図 5】



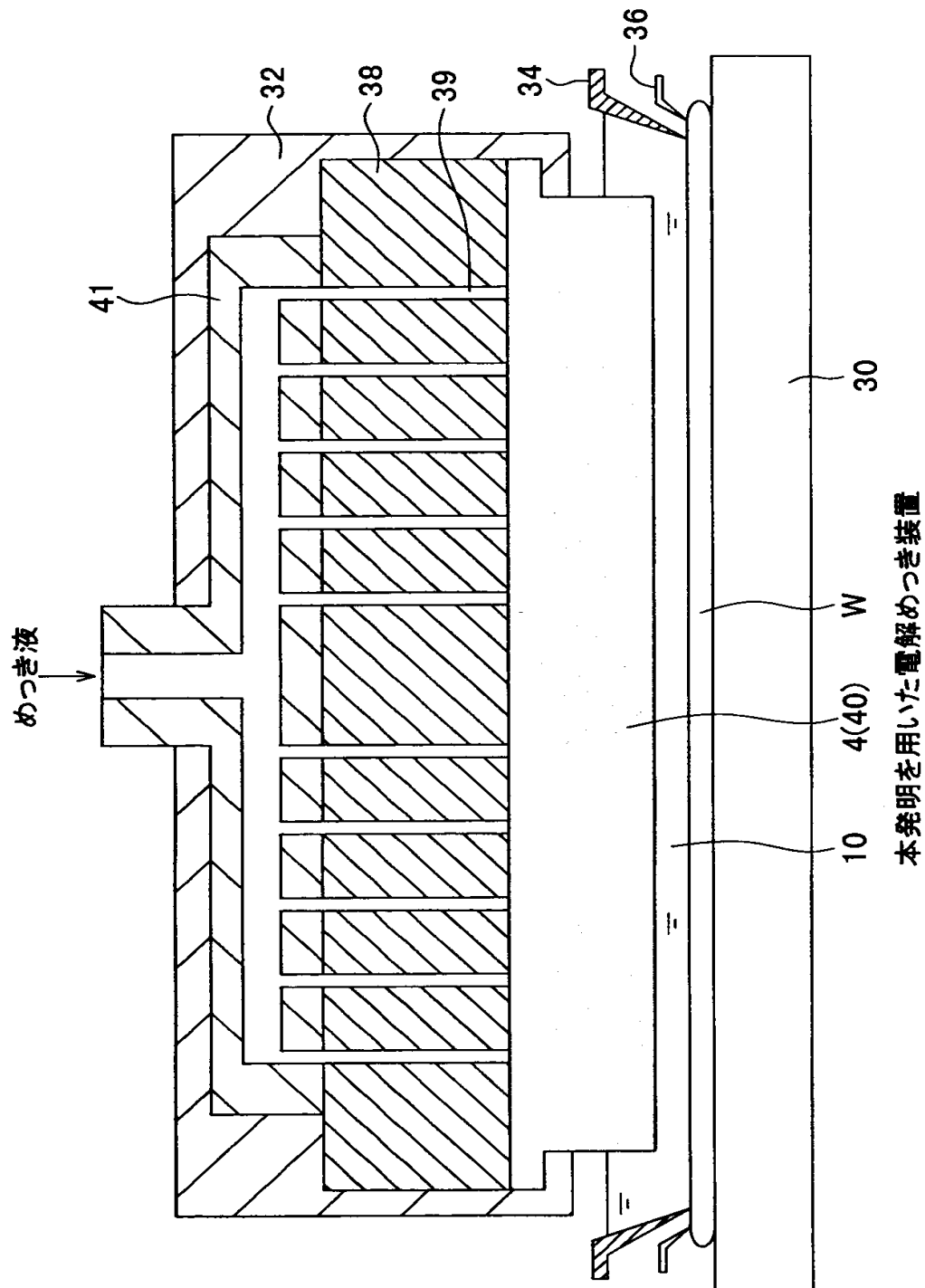
電解めっき装置の多孔質セラミックス板40の外周部分近傍

【図6】

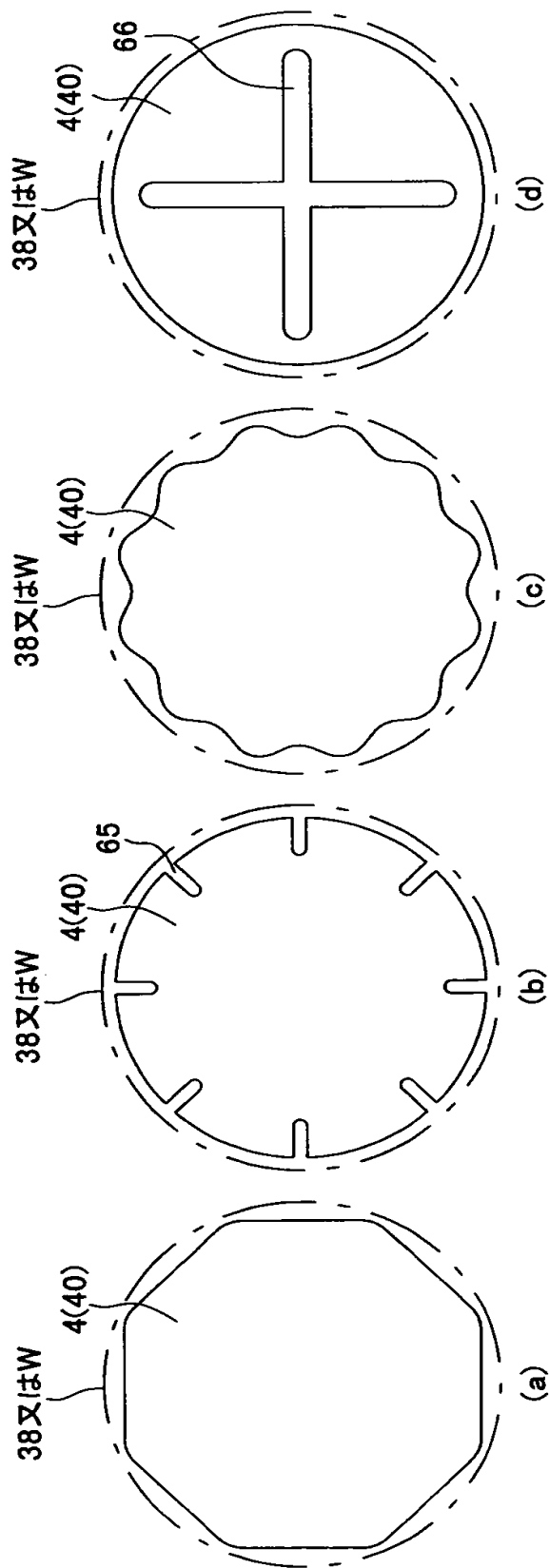


本発明を用いた電解めっき装置

【図 7】

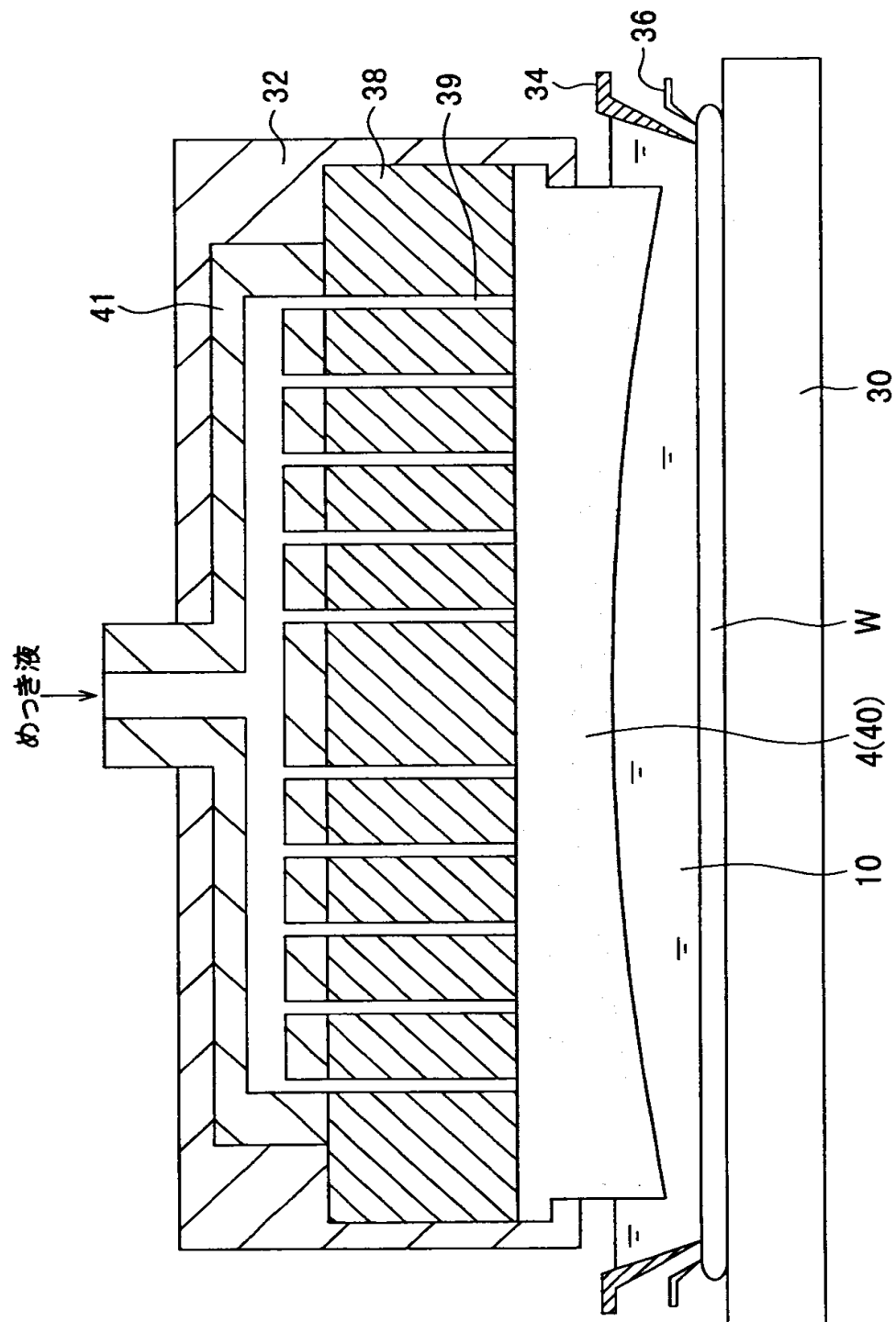


【図 8】

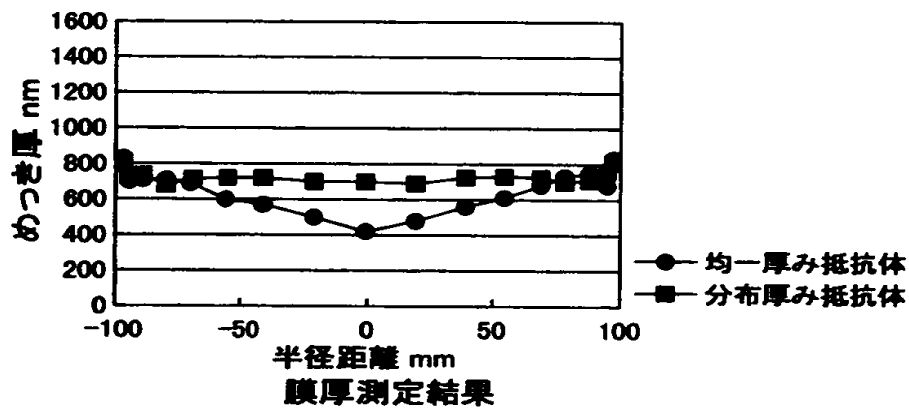


高抵抗構造体4の平面図

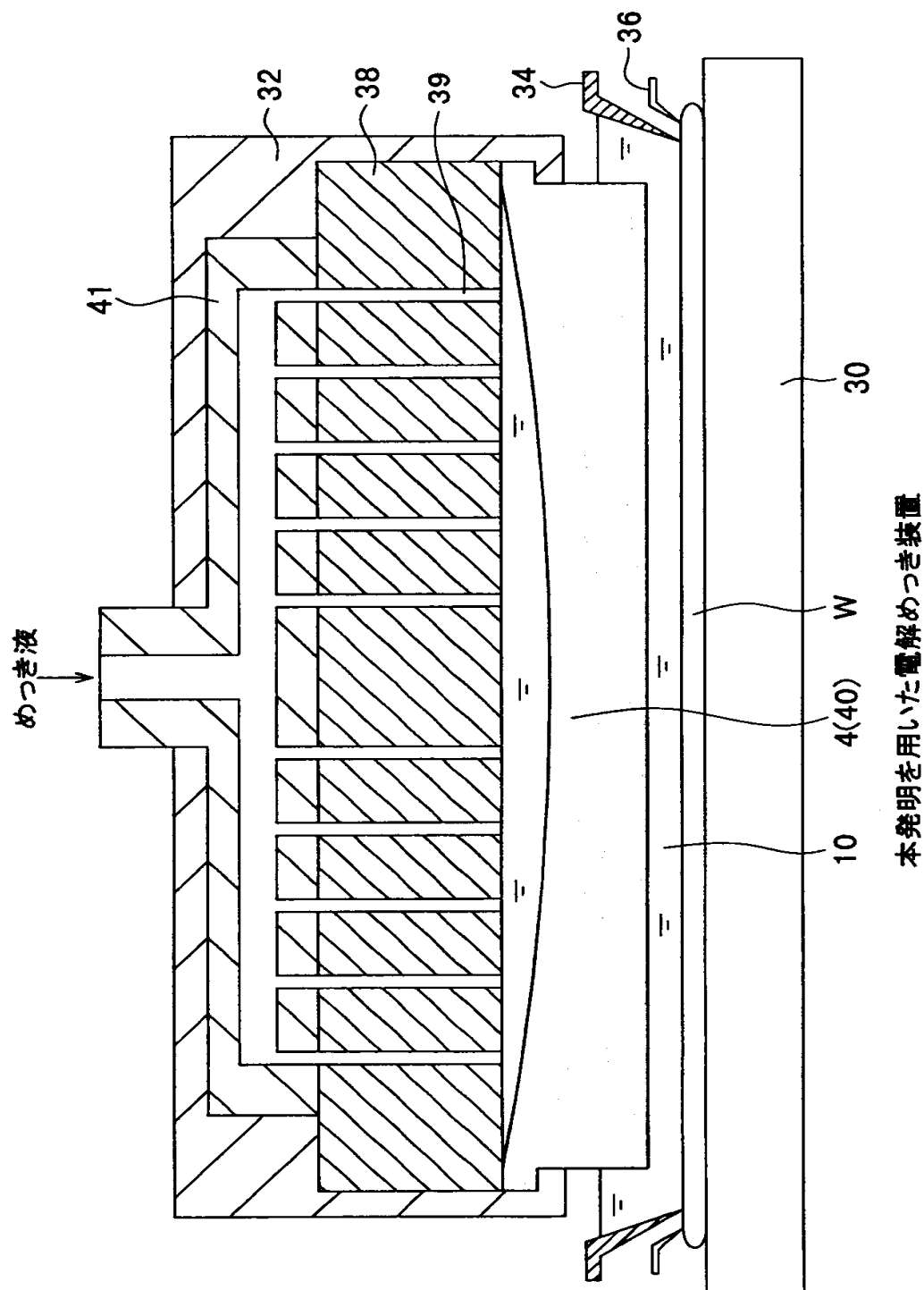
【図9】



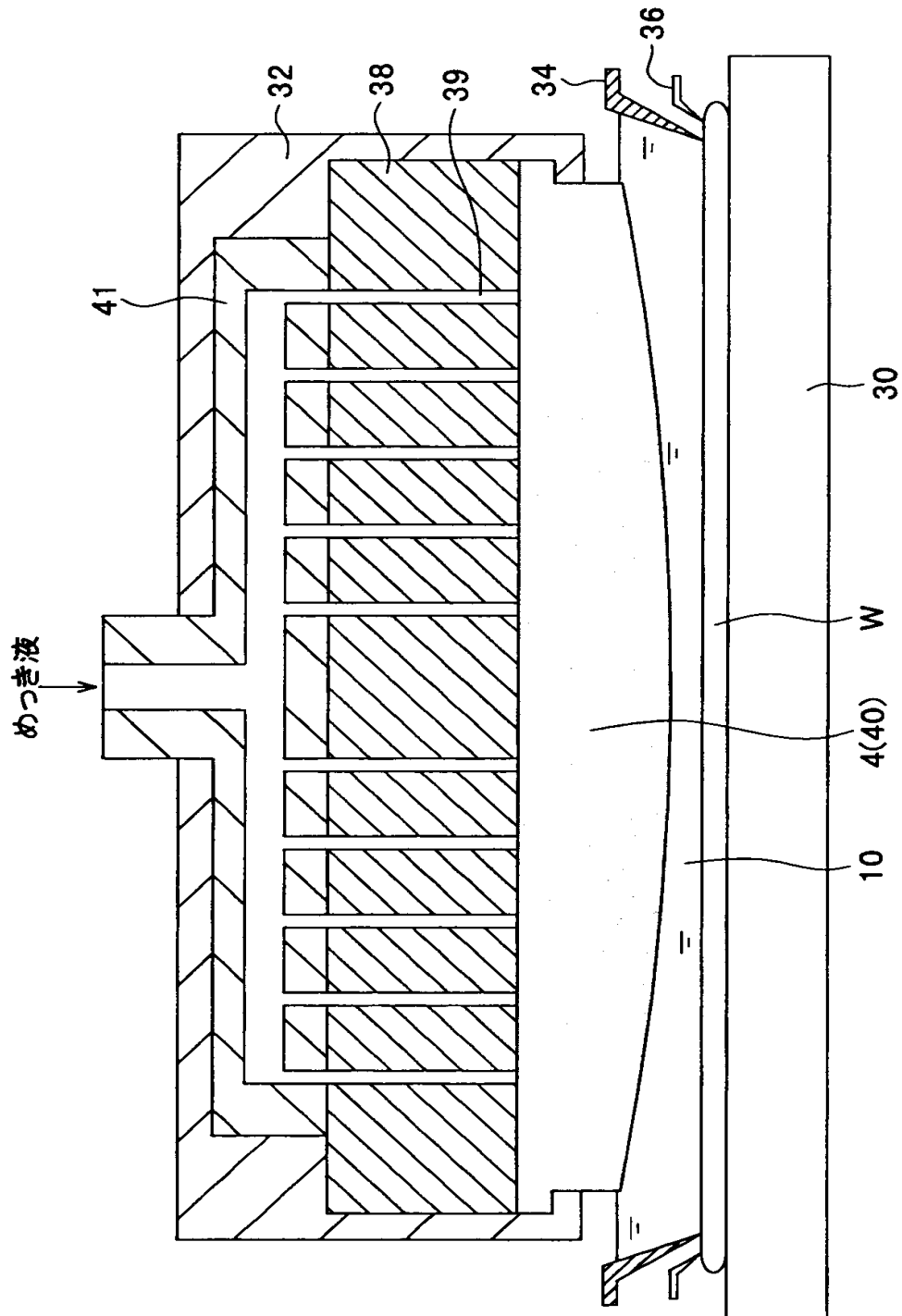
【図10】



【図 11】

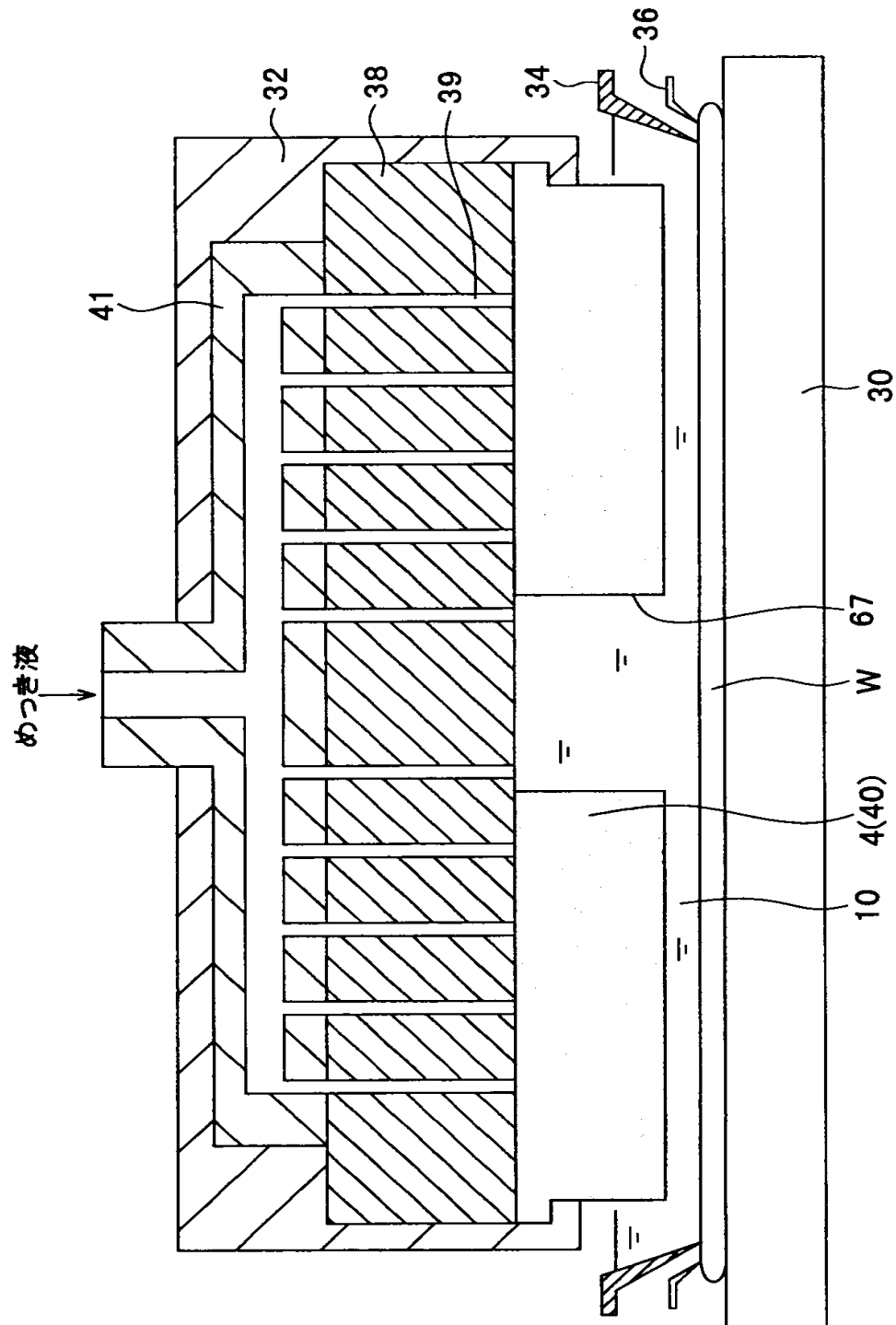


【図 12】



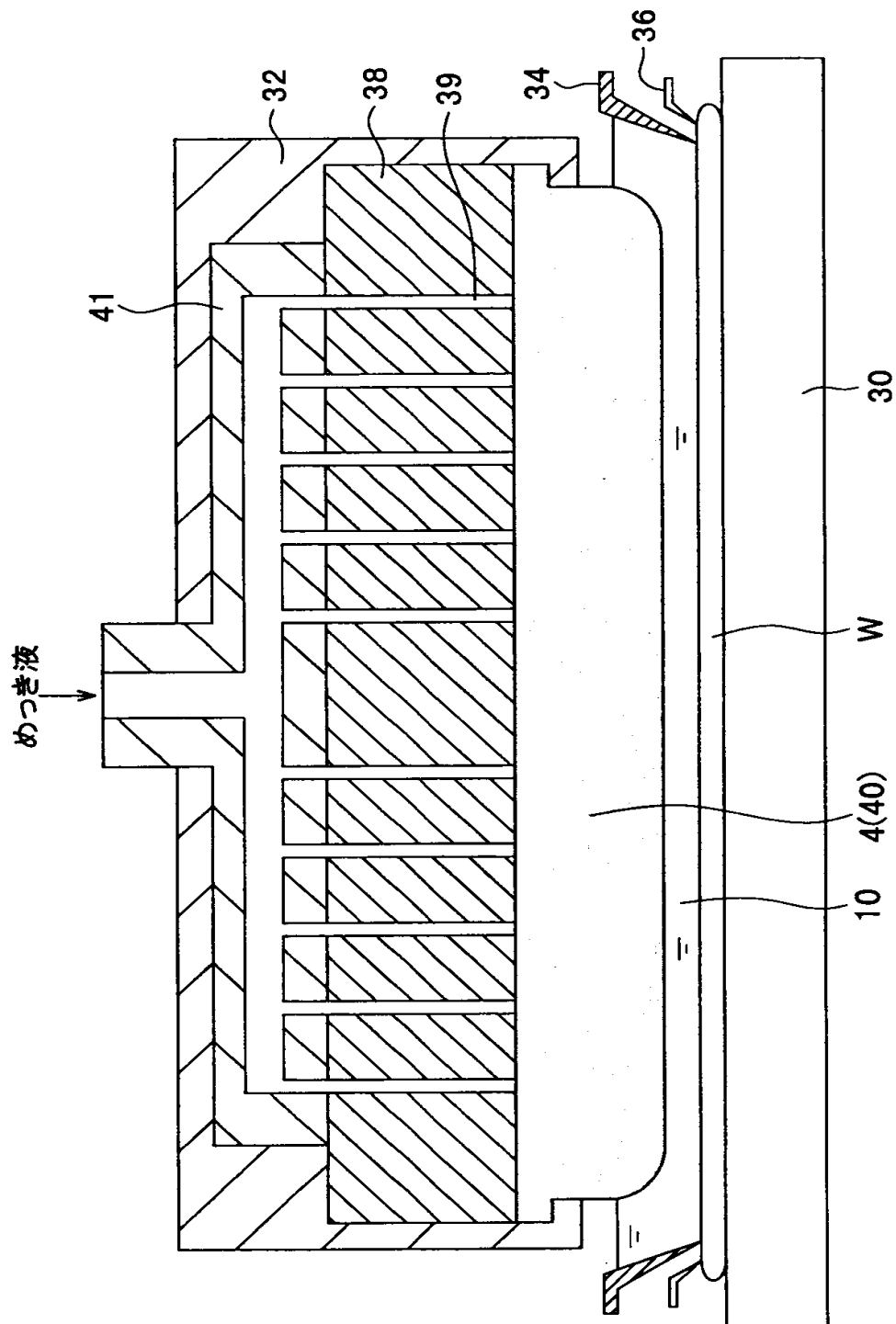
本発明を用いた電解めっき装置

【図 1 3】



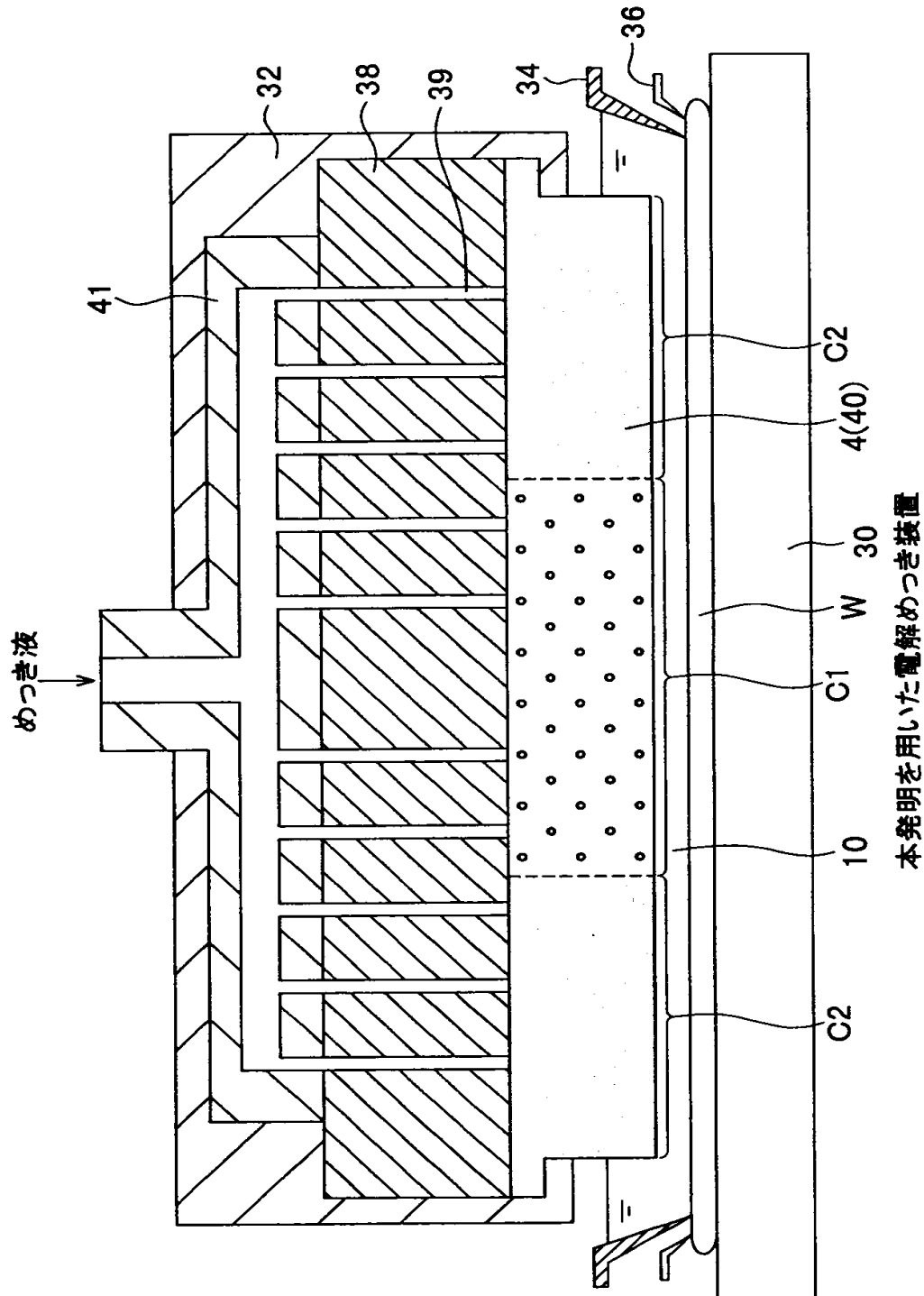
本発明を用いた電解めっき装置

【図14】

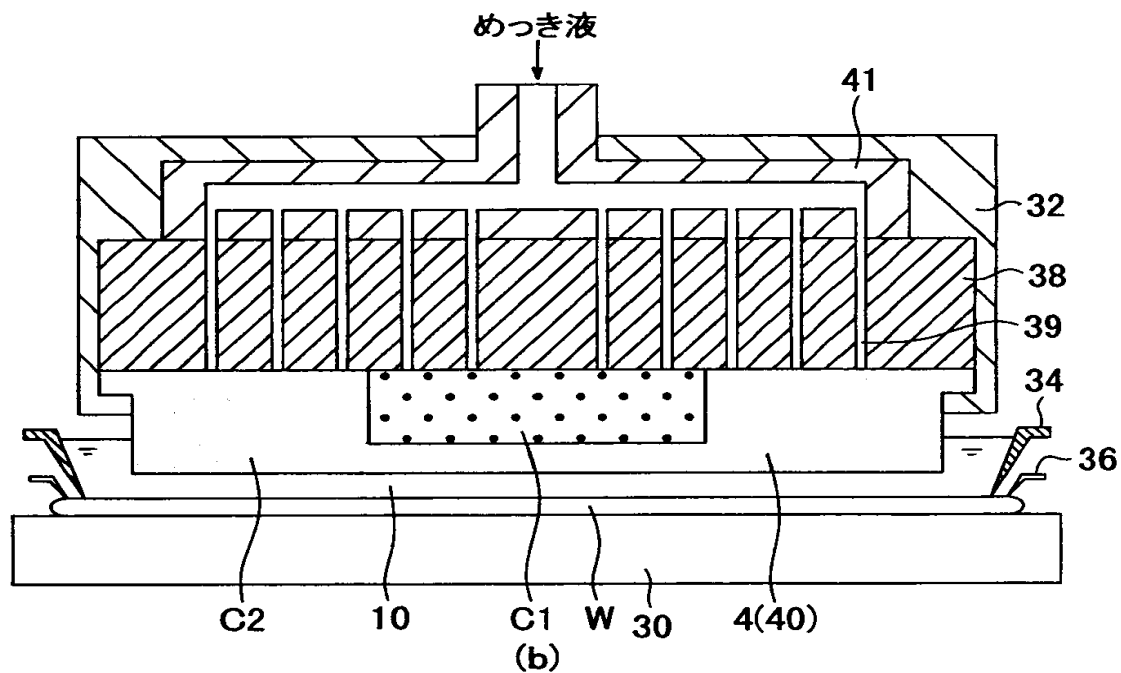
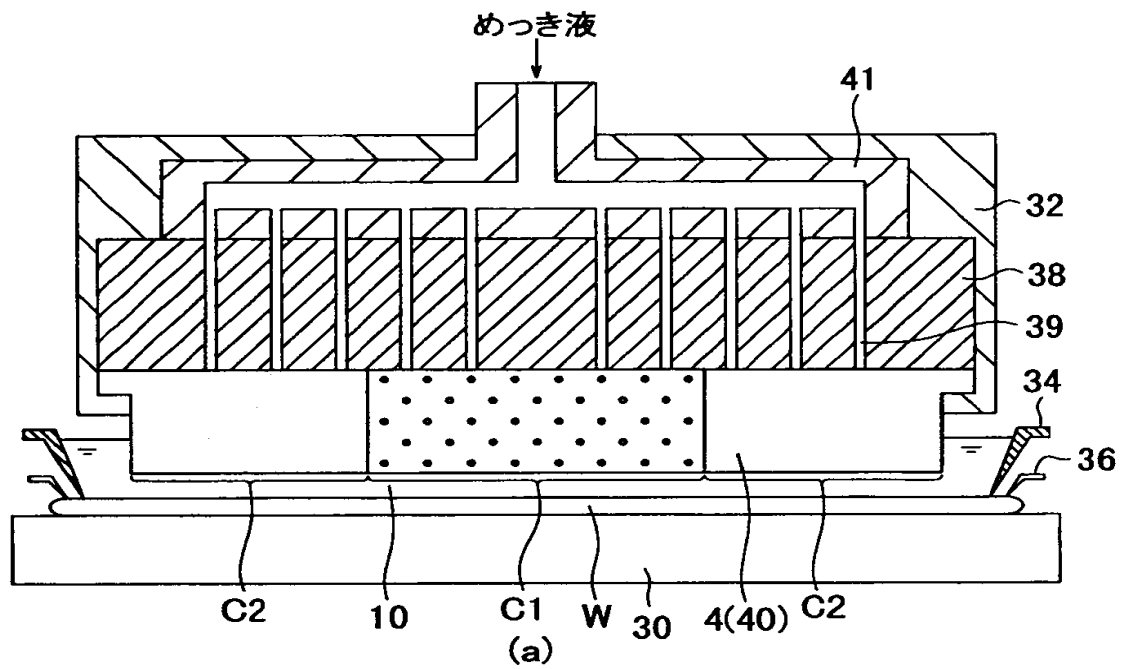


本発明を用いた電解めっき装置

【図 1 5】

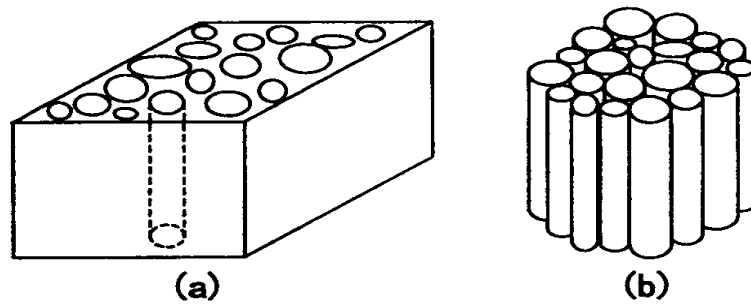


【図 16】



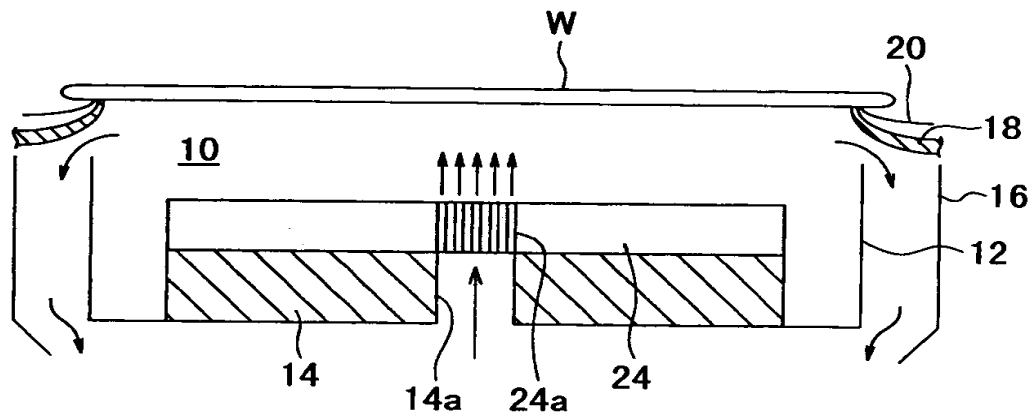
本発明を用いた電解めっき装置

【図17】



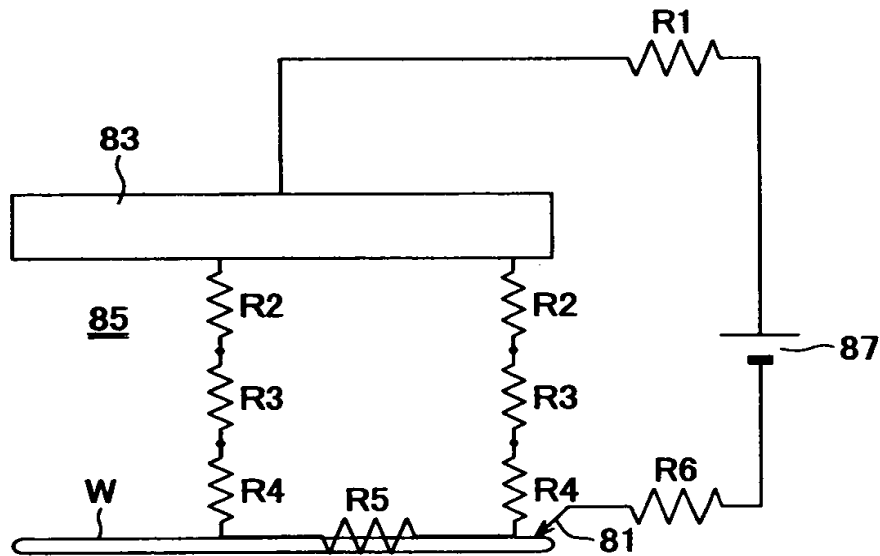
異方性構造材料

【図18】



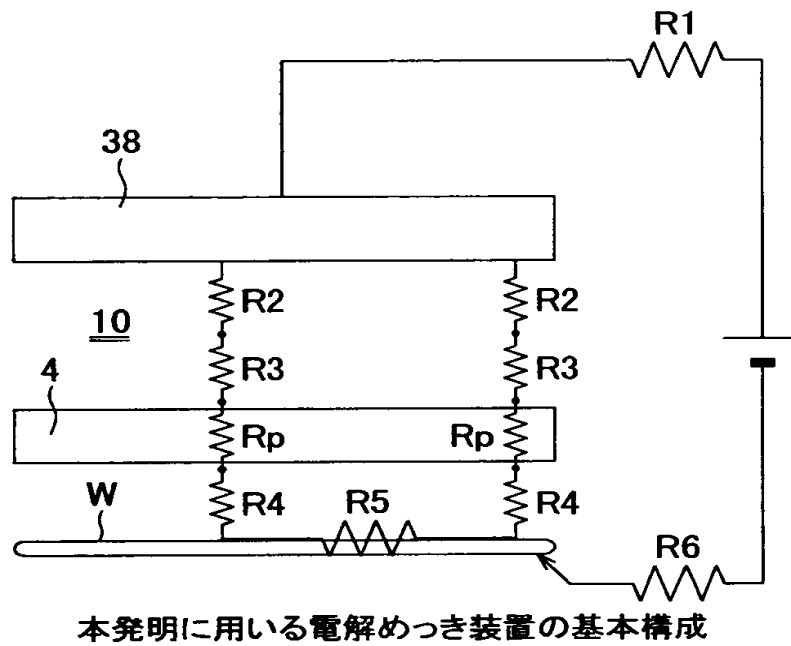
フェイスダウン方式の電解めっき装置

【図19】

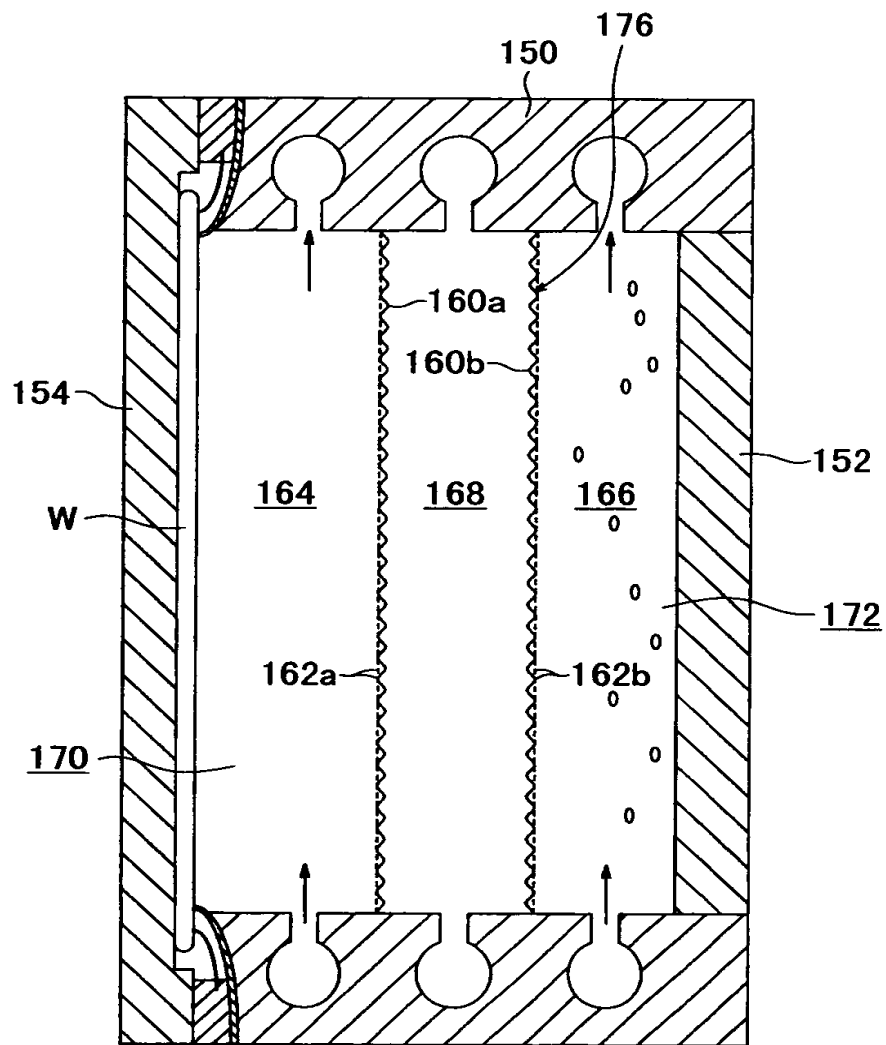


従来の電解めっき装置

【図 20】



【図 21】



密閉式の電解めっき装置

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 積極的に被処理基板表面の電場状態を制御することで、目的とするめっき膜厚の面内分布が得られる電解処理装置及びその電場状態制御方法を提供すること。

【解決手段】 陽極 3 8 と被処理基板 W 間にめっき液 1 0 を満たし、且つ陽極 3 8 と被処理基板 W 間にめっき液 1 0 の電気伝導率よりも低い電気伝導率の高抵抗構造体 4 を設置する。陽極 3 8 と被処理基板 W 間に電流を流した際に被処理基板 W 表面の外周近傍部分の電流密度を低くするために、高抵抗構造体 4 の外周にバンド状の絶縁性部材 5 0 を取りつける。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2000-131879
受付番号	50000550595
書類名	特許願
担当官	小菅 博 2143
作成日	平成12年 8月14日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成12年 4月28日
-------	-------------

【書類名】 手続補正書

【提出日】 平成12年 6月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【事件の表示】

 【出願番号】 特願2000-131879

【補正をする者】

 【識別番号】 000000239

 【氏名又は名称】 株式会社荏原製作所

【補正をする者】

 【識別番号】 000003078

 【氏名又は名称】 株式会社東芝

【代理人】

 【識別番号】 100087066

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 熊谷 隆

 【電話番号】 03-3464-2071

【代理人】

 【識別番号】 100094226

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 高木 裕

 【電話番号】 03-3464-2071

【発送番号】 039581

【手続補正 1】

 【補正対象書類名】 特許願

 【補正対象項目名】 委任状

 【補正方法】 追加

 【補正の内容】

 【提出物件の目録】

 【物件名】 委任状 1

委任状

(B)20001260287



平成12年4月21日

当会社は、識別番号100087066 弁理士 熊谷 隆 氏、
識別番号100094226 弁理士 高木 裕 氏
を以て代理人として下記事項を委任します。

記

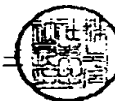
1. 特願2000-121841に関する一切の件
1. 上記出願に基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取下げ
1. 上記出願に関する出願の変更、出願の放棄及び出願の取下げ
1. 上記出願に関する拒絶査定に対する審判の請求及びその取下げ
1. 上記出願に関する補正の却下の決定に対する審判の請求及びその取下げ
1. 上記出願に係る特許権、実用新案権に基づく権利並びにこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄並びにこれらの手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ及び申立ての取下げ
1. 上記出願に係る特許に対する特許異議の申立てに関する手続
1. 上記出願に係る特許、特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録に対する無効審判の請求に関する手続
1. 上記出願に係る特許権及び実用新案権に関する訂正の審判の請求及びその取下げ
1. 上記出願に関する審査官、審判官との面接に関する一切の事項を処理するため復代理人を選任及び解任すること

以上

住 所 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

名 称 株式会社 東芝

代 表 者 取締役社長 西室 泰二



認 定 ・ 付 加 情 報

特許出願の番号	特願 2 0 0 0 - 1 3 1 8 7 9
受付番号	2 0 0 0 1 2 6 0 2 8 7
書類名	手続補正書
担当官	小菅 博 2 1 4 3
作成日	平成 1 2 年 8 月 1 4 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出された物件の記事】

【提出物件名】	委任状（代理権を証明する書面）	1
---------	-----------------	---

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000239]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都大田区羽田旭町11番1号
氏 名	株式会社荏原製作所

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003078]

1. 変更年月日	1990年 8月22日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
氏 名	株式会社東芝